

20A, 600V DP MOS功率管

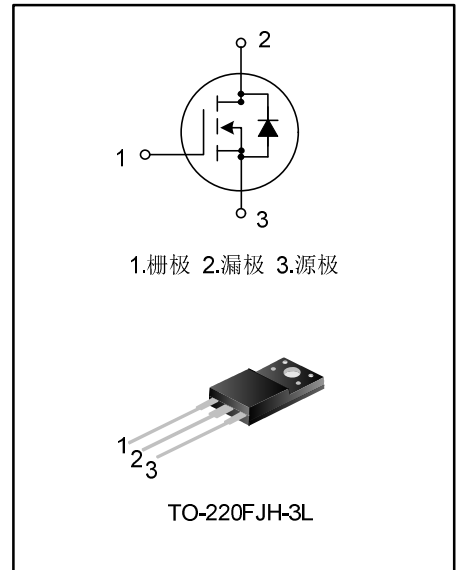
描述

SVS20N60FJHD2 N 沟道增强型高压功率 MOSFET 采用士兰微电子 DP MOS 技术制造，具有很低的传导损耗和开关损耗。使得功率转换器具有高效，高功率密度，提高热行为。

此外，SVS20N60FJHD2 应用广泛。如，适用于硬/软开关拓扑。

特点

- ◆ 20A, 600V, $R_{DS(on)}(\text{典型值})=0.16\Omega@V_{GS}=10V$
- ◆ 创新高压技术
- ◆ 低栅极电荷
- ◆ 定期额定雪崩
- ◆ 较强 dv/dt 能力
- ◆ 高电流峰值



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装形式
SVS20N60FJHD2	TO-220FJH-3L	20N60FJH	无卤	料管

极限参数(除非特殊说明, $T_C=25^{\circ}\text{C}$)

参数名称	符号	参数范围	单位
漏源电压	V_{DS}	600	V
栅源电压	V_{GS}	± 30	V
漏极电流	I_D	$T_C=25^{\circ}\text{C}$	20
		$T_C=100^{\circ}\text{C}$	12
漏极脉冲电流	I_{DM}	80	A
耗散功率($T_C=25^{\circ}\text{C}$) - 大于 25°C 每摄氏度减少	P_D	45	W
		0.36	W/ $^{\circ}\text{C}$
单脉冲雪崩能量(注 1)	E_{AS}	967	mJ
体二极管(注 2)	dv/dt	15	V/ns
MOS管 dv/dt 耐用性(注 3)	dv/dt	50	V/ns
工作结温范围	T_J	$-55\sim+150$	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度范围	T_{stg}	$-55\sim+150$	$^{\circ}\text{C}$

热阻特性

参数名称	符号	参数值	单位
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	2.78	$^{\circ}\text{C/W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.5	$^{\circ}\text{C/W}$

电气参数(除非特殊说明, $T_c=25^\circ\text{C}$)

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	600	--	--	V	
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=600V, V_{GS}=0V$	--	--	200	nA	
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30V, V_{DS}=0V$	--	--	± 100	nA	
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$	2.0	--	4.0	V	
静态漏源导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=10A$	$T_j=25^\circ\text{C}$	--	0.16	0.19	Ω
			$T_j=125^\circ\text{C}$	--	0.30	--	
栅极电阻	R_g	$f=1.0\text{MHz}$	--	2.6	--	Ω	
输入电容	C_{iss}	$V_{DS}=100V, V_{GS}=0V, f=1.0\text{MHz}$	--	1174	--	pF	
输出电容	C_{oss}		--	67	--		
反向传输电容	C_{rss}		--	4.0	--		
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=300V, V_{GS}=10V, R_G=25\Omega, I_D=20A$ (注 4,5)	--	20	--	ns	
开启上升时间	t_r		--	60	--		
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	105	--		
关断下降时间	t_f		--	42	--		
栅极电荷量	Q_g	$V_{DD}=480V, V_{GS}=10V, I_D=20A$ (注 4,5)	--	39	--	nC	
栅极-源极电荷量	Q_{gs}		--	9.6	--		
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}		--	20	--		

源-漏二极管特性参数

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
连续源极电流	I_S	MOS 管中源极、漏极构成的反偏 P-N 结	--	--	20	A
源极脉冲电流	I_{SM}		--	--	80	
二极管压降	V_{SD}	$I_S=20A, V_{GS}=0V$	--	--	1.2	V
反向恢复时间	T_{rr}	$V_{DD}=50V, I_F=20A, di/dt=100A/\mu s$	--	426	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}		--	6.2	--	μC

注:

1. $L=79\text{mH}, I_{AS}=4.6A, V_{DD}=100V, R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_j=25^\circ\text{C}$;
2. $V_{DS}=0\sim 400V, I_{SD}\leq 20A, T_j=25^\circ\text{C}$;
3. $V_{DS}=0\sim 480V$;
4. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$;
5. 基本上不受工作温度的影响。

典型特性曲线

图 1. 输出特性

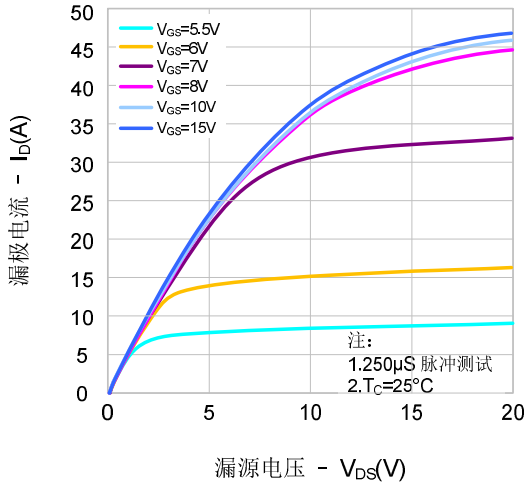


图 2. 传输特性

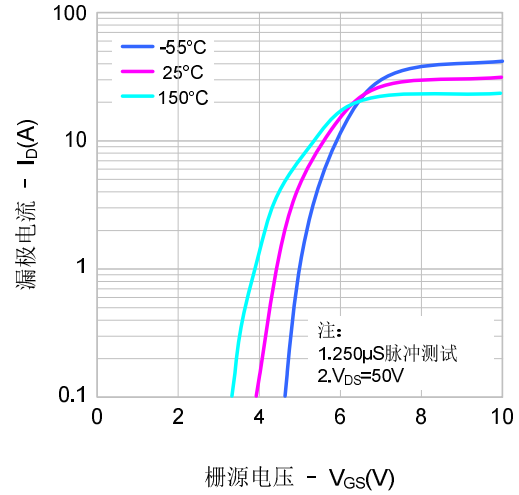


图3. 导通电阻vs.漏极电流

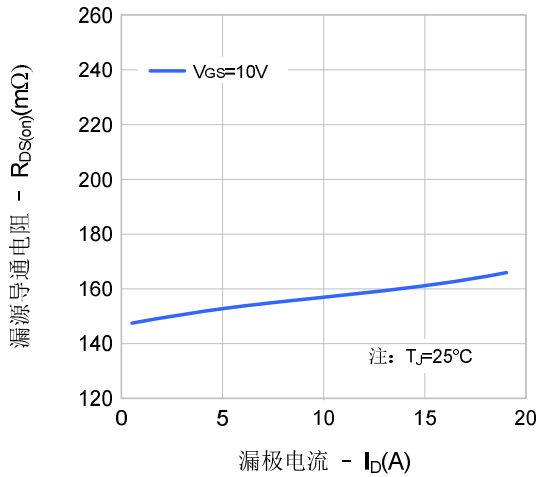


图4. 体二极管正向压降vs. 源极电流、温度

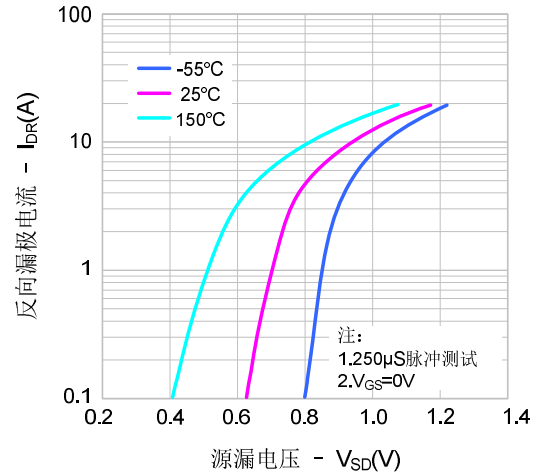


图5. 电容特性

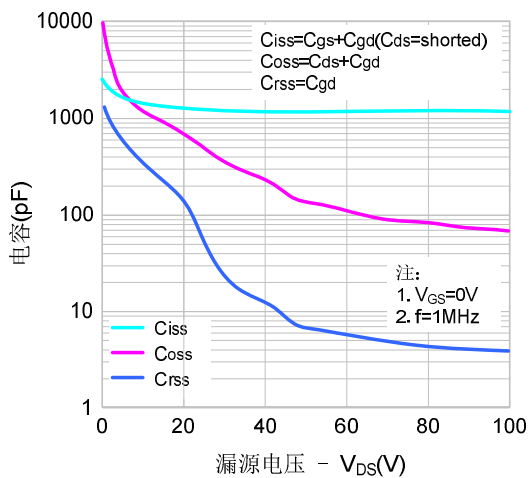
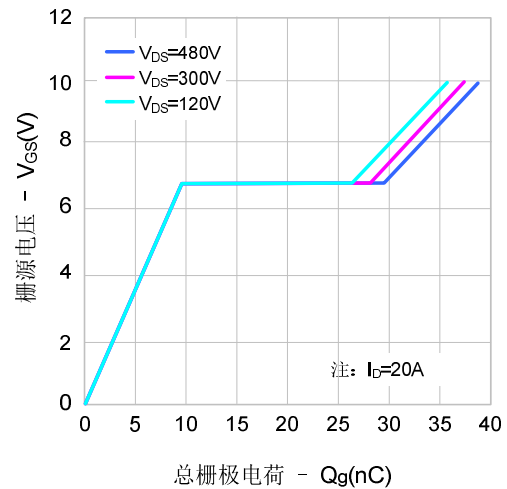


图6. 电荷量特性



典型特性曲线 (续)

图7. 击穿电压vs.温度特性

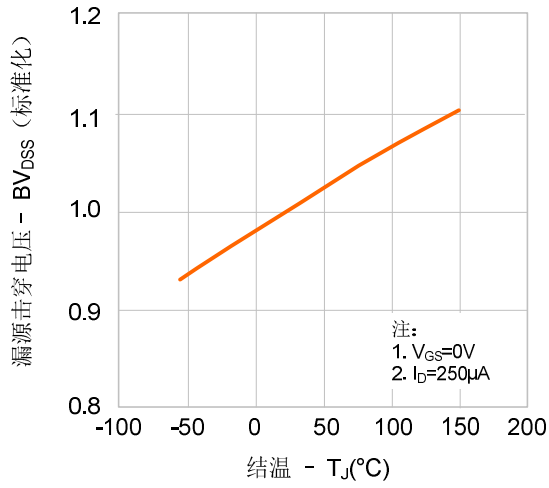


图8. 导通电阻vs.温度特性

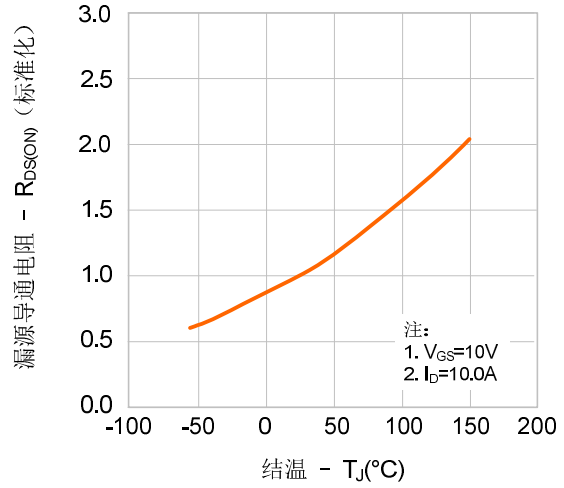
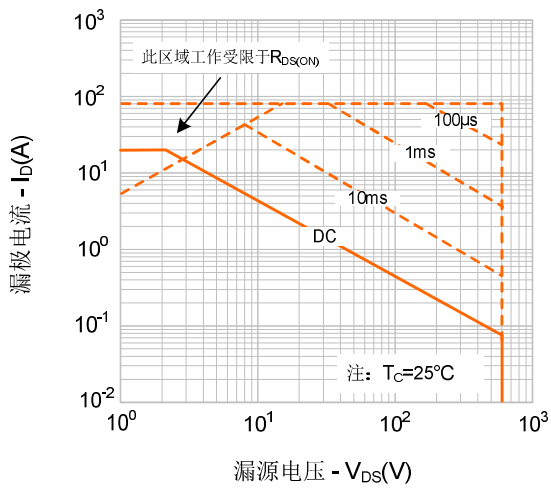
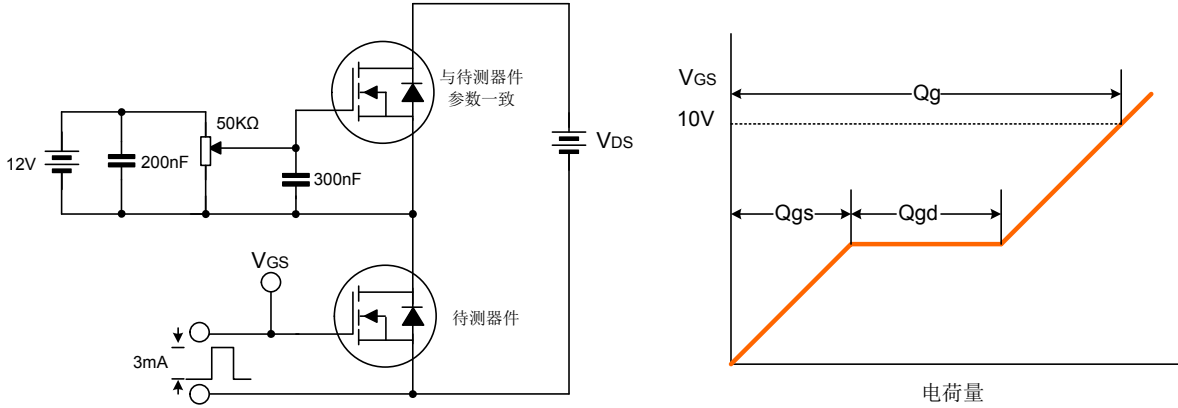


图9. 最大安全工作区域

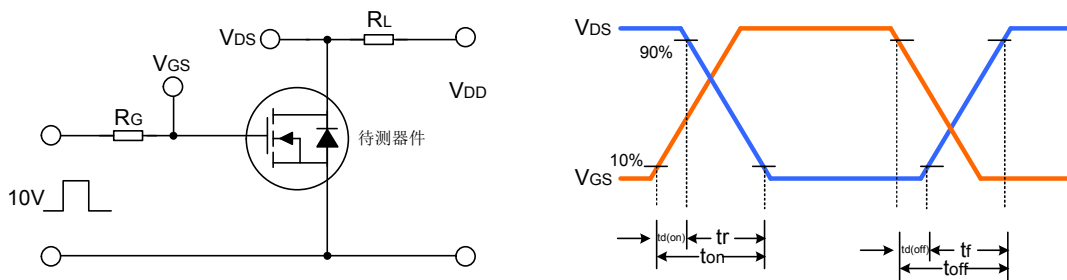


典型测试电路

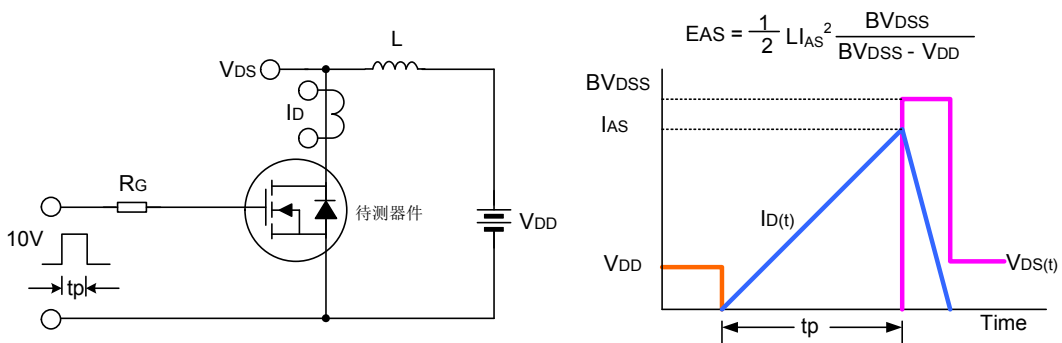
栅极电荷量测试电路及波形图



开关时间测试电路及波形图

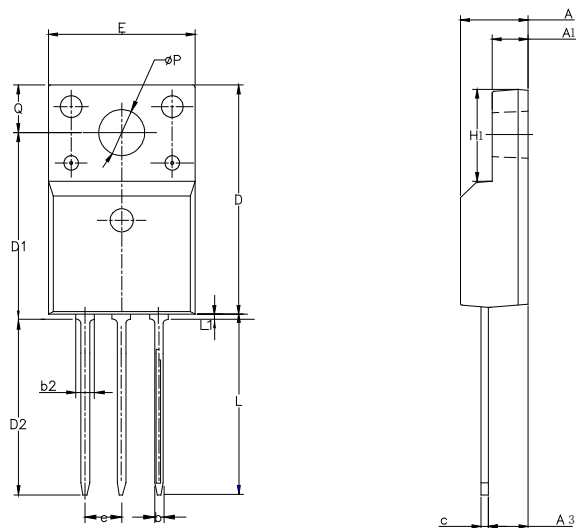


EAS测试电路及波形图



封装外形图
TO-220FJH-3L

单位：毫米



SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	4.42	4.70	5.02
A1	2.30	2.54	2.80
A3	2.50	2.76	3.10
b	0.55	0.70	0.80
b2	—	—	1.29
c	0.35	0.50	0.65
D	15.25	15.87	16.25
D1	12.87	13.07	13.27
D2	12.28	12.48	12.68
E	9.73	10.16	10.36
e	2.54BCS		
H1	6.40	6.68	7.00
L	12.48	12.98	13.48
L1	—	—	0.85
ϕP	3.00	3.18	3.40
Q	3.05	3.30	3.55

声明：

- ◆ 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。
- ◆ 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用 **Silan** 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！
- ◆ 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！

产品名称:	SVS20N60FJHD2	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本: 1.0

修改记录:

1. 正式版本发布
